

2SB552

シリコンPNP三重拡散形トランジスタ

通信工業用

単位: mm

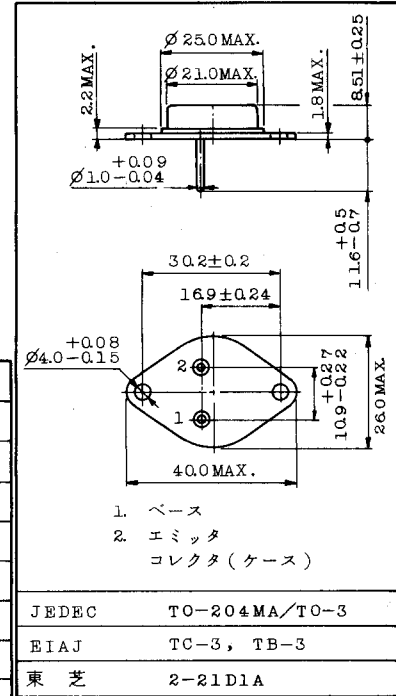
- 大電力増幅用
- 大電力スイッチング用
- DC-DC コンバータ用
- 電源レギュレータ用

特長

- ・ コレクタ損失が大きい。: $P_C=150W$ ($T_c=25^\circ C$)
- ・ コレクタ電流が大きい。: $I_C=-15A$
- ・ 高耐圧です。: $V_{CEO}=-180V$
- ・ 2SD552 とコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-220	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-180	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-15	A
ベース電流	I_B	-3	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ C$)	P_C	150	W
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$



アクセサリはAC73を適用

電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-150V, I_E=0$	-	-	-100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V, I_C=0$	-	-	-1	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-50mA, I_B=0$	-180	-	-	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE}=-5V, I_C=-5A$	25	-	80	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-5V, I_C=-15A$	10	15	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-10A, I_B=-1A$	-	-	-2.0	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-10A, I_B=-1A$	-	-1.6	-2.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-10V, I_C=-1A$	-	3.5	-	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-50V, I_E=0, f=1MHz$	-	300	-	pF
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	-	1	-	μs
	蓄積時間	t_{stg}	-	4	-	
	下降時間	t_f	-	0.5	-	

注: $h_{FE(1)}$ 分類 BN: 25~50, R: 40~80